

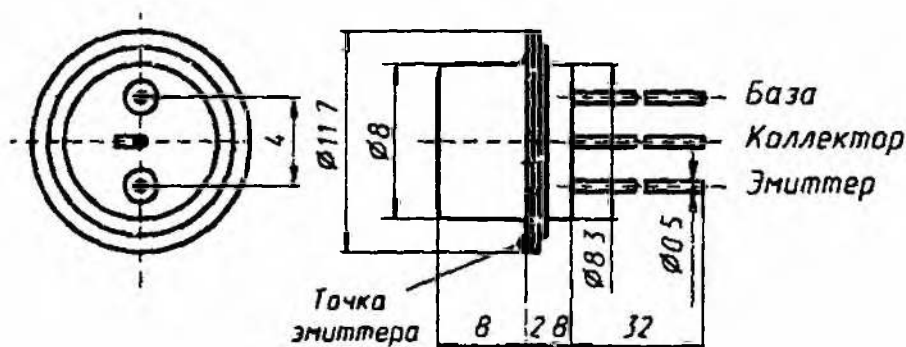
1Т308А, 1Т308Б, 1Т308В, ГТ308А, ГТ308Б, ГТ308В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в автогенераторах, усилителях мощности, импульсных устройствах. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,2 г.

Изготовитель — Нальчинский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик.

1Т308(А-В) ГТ308(А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кб} = 1$ В, $I_3 = 10$ мА:

$T = +25$ °С:

1Т308А, ГТ308А	25...75
1Т308Б, ГТ308Б	50...120
1Т308В, ГТ308В	80...150

$T = +70$ °С:

1Т308А, ГТ308А	От 25 до 3 значений при $T = +25$ °С
1Т308Б, ГТ308Б	От 50 до 3 значений при $T = +25$ °С
1Т308В, ГТ308В	От 80 до 3 значений при $T = +25$ °С

$T = -60$ °С, не менее:

1Т308А, ГТ308А	15
1Т308Б, ГТ308Б	30
1Т308В, ГТ308В	45

Кoeffициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{кБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 500 \dots 1000$ Гц, не менее:	
1Т308Б, ГТ308Б	15
1Т308В, ГТ308В	25
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее:	
1Т308А, ГТ308А	90 МГц
1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, ГТ308В	120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{кБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 5$ МГц, не более:	
1Т308А, 1Т308Б, ГТ308А, ГТ308Б	400 пс
1Т308В, ГТ308В	500 пс
Кoeffициент шума при $U_{кБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 1,6$ МГц для 1Т308В, ГТ308В, не более	
	8 дБ
Время рассасывания при $U_{кЭ} = 10$ В, $I_к = 50$ мА, не более:	
1Т308А, ГТ308А при $I_Б = 4$ мА	1 мкс
1Т308Б, ГТ308Б при $I_Б = 2$ мА	1 мкс
1Т308В, ГТ308В при $I_Б = 1,25$ мА	1 мкс
Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА, не менее	
	15 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_к = 50$ мА, $I_Б = 3$ мА, не более:	
1Т308А, ГТ308А	1,5 В
1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, ГТ308В	1,2 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_к = 50$ мА, $I_Б = 1$ мА, не более	
	0,45 В
Обратный ток коллектора, не более:	
$T = +25$ °С:	
$U_{кБ} = 15$ В	5 мкА
$U_{кБ} = 5$ В	2 мкА
$T = +70$ °С, $U_{кБ} = 10$ В	90 мкА
Обратный ток эмиттера, не более:	
$U_{ЭБ} = 2$ В	50 мкА
$U_{ЭБ} = 3$ В	1000 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кБ} = 5$ В, не более	
	8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1$ В, не более	
	22 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база ¹ при отключенном эмиттере, $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	20 В
Постоянное напряжение коллектор—база ¹ при обратном смещении на эмиттере, $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$...	30 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{\text{БЭ}} = 1\text{ кОм}$, $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	12 В
Постоянное напряжение эмиттер—база ¹ при $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	3 В

При $T = +45\dots+70\text{ }^\circ\text{C}$ предельно эксплуатационные данные уменьшаются через каждые $5\text{ }^\circ\text{C}$; постоянное и импульсное напряжение коллектор—база на 1 В, постоянное напряжение коллектор—эмиттер на 0,4 В, постоянное напряжение эмиттер—база на 0,2 В.

Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора ¹ при $t_{\text{и}} = 5\text{ мкс}$, $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	120 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ² при $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	150 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $t_{\text{и}} = 5\text{ мкс}$, $T = +45\text{ }^\circ\text{C}$	360 мВт
Температура p - n перехода	+85 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-60...+70 $^\circ\text{C}$

При $T = +45\dots+70\text{ }^\circ\text{C}$ предельно эксплуатационные данные уменьшаются через каждые $5\text{ }^\circ\text{C}$; импульсный ток коллектора на 4 мА, импульсная рассеиваемая мощность на 10 мВт.

² При $T = +45\dots+70\text{ }^\circ\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{\text{к, макс}} = 4 (85 - T), \text{ мВт.}$$